

	<p>SI4888DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4888DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4888DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



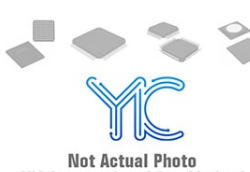
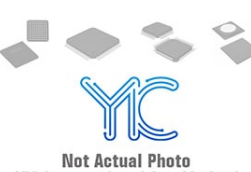
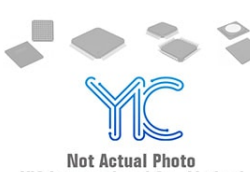
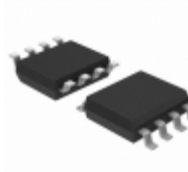
Spezifikationen

Teilenummer	SI4888DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 11A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

SI4888DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4888DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4888DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4888DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4888DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>SI4890BDY-T1 VISHAY SI4890BDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4890BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p>SI4888DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>
 <p>SI4890 SI SI4890 SI</p>	 <p>SI4888DY-T1 VISHAY SI4888DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4888DY-T1-E3. VIS SI4888DY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI4888DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4888DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4888DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4888DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4888DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4888DY-T1-GE3
SI4888DY-T1-GE3 Electronic	SI4888DY-T1-GE3-Komponenten	SI4888DY-T1-GE3-Verteiler	SI4888DY-T1-GE3-Bild	SI4888DY-T1-GE3-Teil
SI4888DY-T1-GE3 Preis	SI4888DY-T1-GE3 Hersteller	SI4888DY-T1-GE3 Bild	SI4888DY-T1-GE3 Aktie	SI4888DY-T1-GE3 Inventar
SI4888DY-T1-GE3 Neu	SI4888DY-T1-GE3 Original	SI4888DY-T1-GE3 garantiert	SI4888DY-T1-GE3 RFQ	SI4888DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited